



*Рис. 5.* Зависимость величины емкости подзатворного оксида ( $C_{ox}$ ) транзистора от дозы имплантации азота ( $D_{N^+}$ ) при прямом ( $F$ ) и обратном ( $B$ ) порядке БТО для контрольных ( $W/O$ ) и имплантированных ( $N^+$ ) образцов

*Fig. 5.* Dependence of the capacitance value of the gate oxide ( $C_{ox}$ ) of transistor on the dose of nitrogen implantation ( $D_{N^+}$ ) with the direct ( $F$ ) and reverse ( $B$ ) order of rapid thermal annealing for control ( $W/O$ ) and implanted ( $N^+$ ) samples